



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H928S

对应国外型号
KSA928A

主要用途

作音频放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	750mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-30V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-30V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-2A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-30			V	$I_C=-100 \mu\text{A}, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-30			V	$I_C=-10\text{mA}, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-1\text{mA}, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$
H_{FE}	直流电流增益	100		320		$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=-500\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-2	V	$I_C=-1.5\text{A}, I_B=-30\text{mA}$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压			-1	V	$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=-500\text{mA}$
f_T	特征频率		120		MHz	$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=-500\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		48		pF	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$

分档及其标志

0

Y

100—200

160—320